

单位: mil

LPOBE35A

产品特性:

芯片尺寸: 35mil x 35mil
(890±50μm x 890±50μm)
芯片厚度: 6mil(150±20μm)
焊盘尺寸: P焊盘:14milx33.5mil
(350±30μm x 850±50μm)
N焊盘:14milx33.5mil
(350±30μm x 850±50μm)

焊盘金属

P焊盘: AuSn

N焊盘: AuSn



LatticePower

产品介绍

Product Introduction

LPOBE35A



LatticePower

产品介绍

Product Introduction

LPOBE35A

最大额定值

DC 正向电流	700mA
正向峰值电流(1/10占空比@1kHz)	1000mA
LED结温	115℃
反向电压	5V
使用温度范围	-40 ~ 85℃
贮存温度范围	0 ~ 40℃

说明:

- 1.最大额定值为晶能光电封装条件下测试得到,不同封装形式得到的值会有所不同,建议在不超过最大额定值的条件下使用,超过最大额定值使用可能会引起LED芯片损坏。
- 2.本产品非设计与逆向电流(压)下使用,不建议在任何逆向电流(压)下使用。

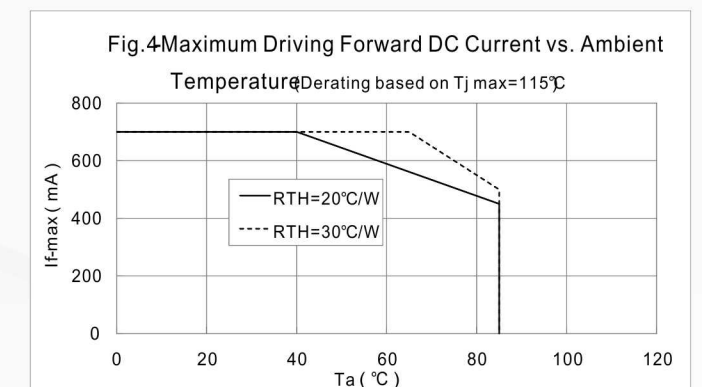
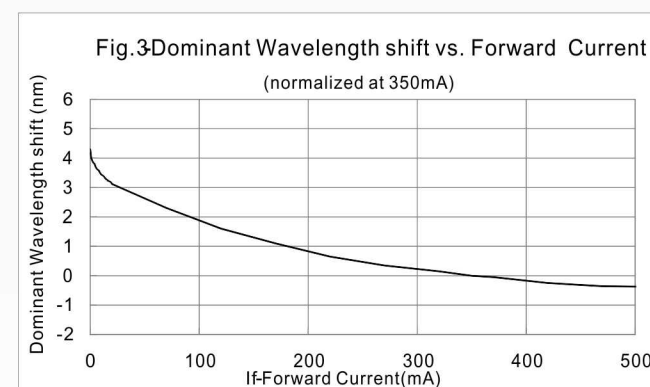
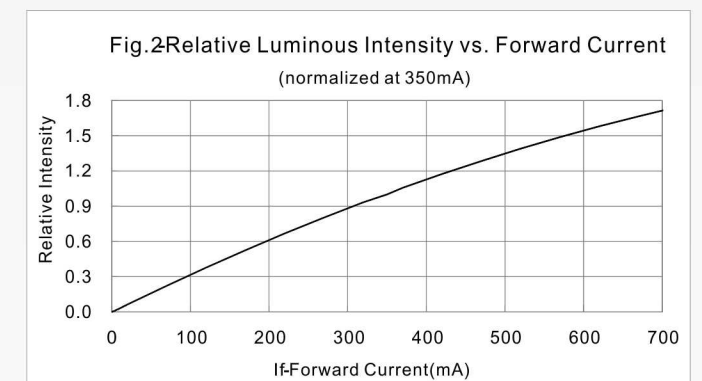
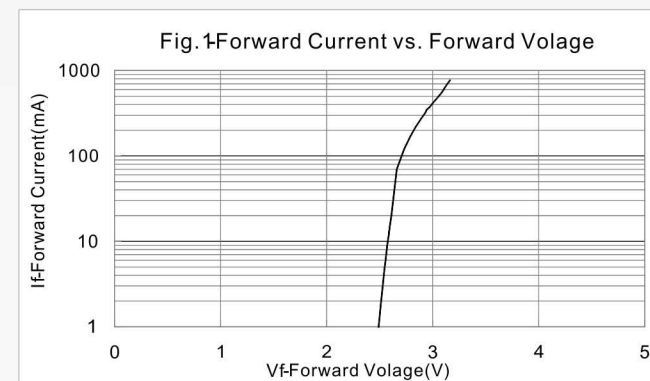
光电参数

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
开启电压	V _{f1}	I _f =10μA	2.0	---	2.8	V
工作电压	V _{f2}	I _f =350mA	2.8	---	3.6	V
反向漏电流	I _R	V _r =5V	---	---	2	μA
主波长	λ _d	I _f =350mA	445	---	475	nm
半波宽度	Δλ	I _f =350mA	---	---	30	nm
光强	P _o	I _f =350mA	420	---	525	mW

参数等级:

P _o (mW)	W _d (nm)	447.5-450	450-452.5	452.5-455	455-457.5	457.5-460	460-462.5
500-525	FBES	GAES	GBES	HAES	HBES	IAES	
480-500	FBNU	GANU	GBNU	HANU	HBNU	IANU	
460-480	FBMU	GAMU	GBMU	HAMU	HBMU	IAMU	
440-460	FBLU	GALU	GBLU	HALU	HBLU	IALU	
420-440	FBKU	GAKU	GBKU	HAKU	HBKU	IAKU	

特性曲线



其它说明:

1. 光电参数为采用晶能光电测试仪器在室温下(T_A=25℃)测试结果;
2. GaN芯片为静电敏感产品,请在使用、运输时注意静电保护;
3. 可根据客户要求订做特殊规格芯片;

LatticePower

LatticePower